

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 103.55 357.6

Anmeldetag: 25. November 2003

Anmelder/Inhaber: TransMIT Gesellschaft für Technologietransfer mbH,
35394 Gießen/DE

Erstanmelder: Osram Opto Semiconductors GmbH,
93049 Regensburg/DE

Bezeichnung: Optisch gepumpte Halbleitervorrichtung zur Erzeugung langwelliger Strahlung

IPC: H 01, S 5/40

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 18. Februar 2005
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag


Wehner



Optisch gepumpte Halbleitervorrichtung zur Erzeugung langwelliger Strahlung

B Die vorliegende Erfindung beschreibt die Herstellung und Realisierung von langwelligem MILOS-Scheibenlasern (MILOS=Monolithic Integrated Lateral Optical Pumped Semiconductor), extern optisch Barriere/Quantenfilm-gepumpten und elektrisch gepumpten Scheibenlasern mittels Epitaxie (MBE, MOMBE, GSMBE, MOVPE). Für die Realisierung von langwelligem Scheibenlasern $>1000\text{nm}$ werden für die Lichterzeugung kompressiv gespannte InGaAs-Quantenfilme mit In-Konzentrationen mit typ. $>18\%$ und Schichtdicken mit typ. $<10\text{nm}$ benötigt. Diese können z.B. bei MOVPE-Wachstumstemperaturen von $>600^\circ\text{C}$ mit guter Qualität nur für Wellenlängen bis ca. 1000nm hergestellt werden, da oberhalb der kritischen Schichtdicke eine Relaxation der gespannten Einzelschichten einsetzt.

Eine weitere Erhöhung der kritischen Schichtdicke kann durch eine geringere Energiezufuhr, d.h. z.B. durch eine niedrigere Wachstumstemperatur $T < 600^\circ\text{C}$ erzielt werden. Aufgrund der geringen Zerlegungseffizienz von AsH_3 - und PH_3 -Gruppe-V-Gasquellen in der MOVPE bei diesen niedrigen Temperaturen ist der Einsatz alternativer TBAs- und TBP-Quellen mit deutlich besseren Zerlegungseigenschaften notwendig. Neben InGaAs-Quantenfilmen können mit entsprechenden N-Quellen (Hydrazin) und Sb-Quellen InGaAsN, InGaAsSb, InGaAsNSb, GaAsN, AlAsN, GaAsSb, AlAsSb, GaAsP-Schichten als Quantenfilm- und Barrierenstrukturen auf GaAs hergestellt werden. Damit können insbesondere in der MOVPE folgende GaAs-basierende Wellenlängen für Scheibenlaser/ VECSEL zugänglich gemacht werden (VECSEL=Vertical External Cavity Surface Emitting Laser):

Quantenfilme:	Wellenlängen:
InGaAs	$<1000\text{nm}$ (Standardquellen)
InGaAs	$<1100\text{nm}$ (TBAs, TBP)
InGaAsN	$<1300\text{nm}/1500\text{nm}$ (TBAs, TBP)
InGaAsNSb	$<2000\text{nm}$ (TBAs, TBP, Sb-Quellen)

Das Design je nach Wellenlänge ist insbesondere für effiziente Scheibenlaserstrukturen kritisch und wird im Folgenden exemplarisch für die zwei (fundamentalen) Wellenlängen 1050nm (frequenzverdoppelt grün) und 1260nm (frequenzverdoppelt rot) beschrieben. Diese Wellenlängen eröffnen neben den bisher bekannten Wellenlängen u.a. den ganzen sichtbaren Wellenlängen durch resonatorinterne Frequenzverdopplung.

Bei der Epitaxie von Scheibenlaser bei 1050nm Emissionswellenlänge kann eine erhöhte In-Konzentration bei niedrigen Wachstumstemperaturen von $T < 600^\circ\text{C}$ mit alternativen TBAs-Quellen für die InGaAs-Quantenfilme zur Lichterzeugung und TBP-Quellen für die verspannungskompensierenden Barrierenschichten in der Aktiven realisiert werden. Das Design mit ungefähren Schichtdicken ist in Abb. 1 zu sehen. Bei dieser Wellenlänge ist i.d.R. noch keine Verspannungskompensation der hochaluminiumhaltigen Schichten, die insbesondere in den Braggreflektoren zum Einsatz kommen, notwendig.

Für Scheibenlaser bei längeren Wellenlängen ist dann i.d.R. auch eine Kompensation der Verspannung des Braggspiegels bei niedrigen Wachstumstemperaturen für die unterschiedlichen Materialien (typ. AlAs-, GaAs-, bzw. $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ -Schichten mit variierendem Al-Gehalt) mit Brechungsindexsprung vorteilhaft, da bereits während der

Epitaxie diese Materialkombinationen unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten haben und zu einer Materialdegradation führen können.

Dazu gibt es verschiedene Verspannungskompensationskonzepte, bei der hier insbesondere in den hochaluminiumhaltigen AlGaAs/AlAs-Schichten durch geringe Konzentrationen von P die leicht kompressive Verspannung durch das Aluminium tensil kompensiert werden kann. Die Barrierenschichten müssen je nach optischer Absorptionswellenlänge und -konzept für einen effizienten Betrieb sehr kritisch untersucht werden. Wie in Abb. 2 dargestellt, kann als Absorptionsschicht neben GaAsP und AlGaAs-Schichten für Absorptionswellenlängen $< 900\text{nm}$ auch InGaAsN oder GaAsN mit Absorptionswellenlängen $> 900\text{nm}$ hergestellt werden. Dabei ist je nach Materialkombination auf das ausreichende Ladungsträgerkonfinement in Leitungs- und Valenzband zu achten. Insbesondere für InGaAsN-Quantenfilme zur Lichterzeugung ist ein ausreichendes Löcherkonfinement durch den Einsatz von GaAsP/AlGaAs-Schichten im Design für einen effizienten Laserbetrieb notwendig, da das Löcherkonfinement tatsächlich geringer ist als in Abb. 2 dargestellt. Eine weitere Variante für 1260nm ist z.B. in Abb. 3 zu sehen. Die Schichtdicken sind entsprechend der Wellenlänge bei 1260nm anzupassen.

Patentanspruch:

Optisch gepumpter Halbleiterlaser mit einer fundamentalen Emissionswellenlänge,
die größer als 1000nm ist.

1260nm Disklaser Design V2 (808nm-Pumpabsorbinglayer, bzw. geeignet für extern oder monolit. integr. l

	daol	d (nm)	Eg (eV)	dEe (eV)	Ee (eV)	dEp (eV)	Ep (eV)
Wirkungsgrad	0,0%	413,70	1,892	0,182	1,892	-0,200	-0,200
Pumpabsorb (810nm)	0,0%	0,1	1,831	0,073	1,489	-0,039	-0,039
Pumpabsorb (810nm)	0,0%	228,00	1,531	0,073	1,403	-0,039	-0,039
QW	16,3%	10,5	1,259	-0,124	1,259	0,031	0,031
Bragg	10,5	31,4	1,54	0,034	1,504	-0,039	-0,039
Pumpabsorb (810nm)	0,0%	101,37	1,531	0,073	1,403	-0,039	-0,039
QW	>20%	10,5	1,259	-0,124	1,259	0,031	0,031
Bragg	10,5	31,4	1,54	0,034	1,504	-0,039	-0,039
Pumpabsorb (810nm)	0,0%	101,37	1,531	0,073	1,403	-0,039	-0,039
QW	>30%	10,5	1,259	-0,124	1,259	0,031	0,031
Bragg	10,5	31,4	1,54	0,034	1,504	-0,039	-0,039
Pumpabsorb (810nm)	0,0%	101,37	1,531	0,073	1,403	-0,039	-0,039
Bragg	AlGaP	94,78	2,833	0,833	2,559	-0,480	-0,480
Bragg	GaAs	73,28	1,873	0,187	1,587	-0,088	-0,088
Bragg	AlGaP	94,78	2,833	0,833	2,559	-0,480	-0,480
Buffer	GaAs	200	1,42		1,420		0,000
GaAs-Substrat	GaAs	7007,5					

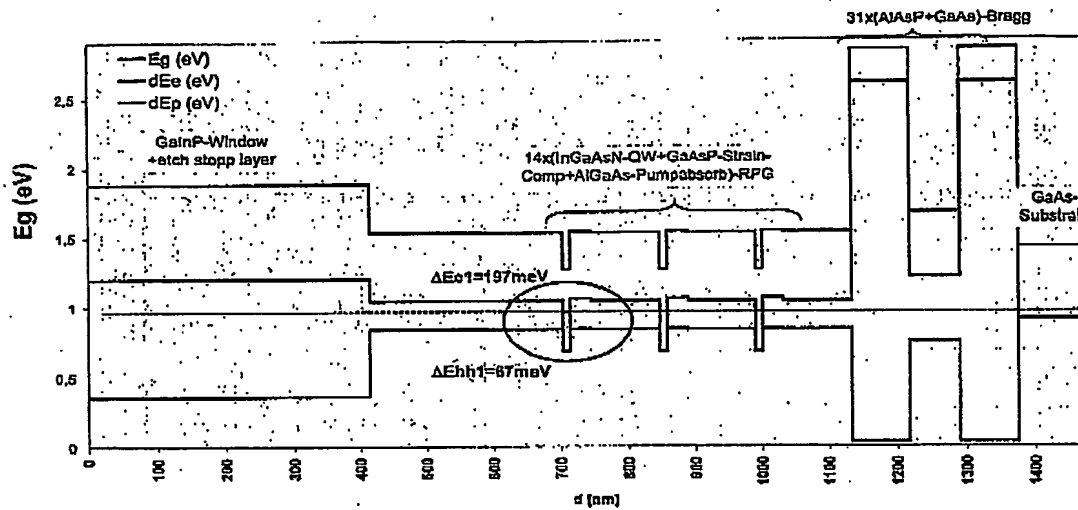


Abb. 3: Design für 1260nm Scheibenlaser mit GaAsP-Barrierenschichten für besseres Ladungsträgerconfinement und mit verspannungskompensierten AlGaAsP-Bragg-Spiegeln.

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/DE04/002624

International filing date: 25 November 2004 (25.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: DE
Number: 103 55 357.6
Filing date: 25 November 2003 (25.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 01 March 2005 (01.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.